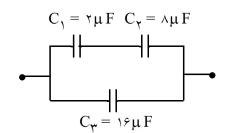
$$7\mu F$$
 $7\mu F$ $7\mu F$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در خازنهای سری، انرژی ذخیره شده با ظرفیت نسبت عکس دارد. پس انرژی ذخیره $\frac{9}{W} = \frac{4}{W_1} \Rightarrow W_1 = 7\,\mathrm{mJ}$ شده در خازن $\frac{9}{W} = \frac{4}{W_1} \Rightarrow W_2 = 7\,\mathrm{mJ}$

$$\frac{\rho\mu F}{\gamma\mu F} = \frac{W_{\gamma}}{\gamma} \Longrightarrow W_{\gamma} = \rho mJ$$

و در خازن ۲µF برابر ۶ میلی ژول می باشد.

یس در مجموع سه خازن (7+9+4+7+7) ذخیره شده است.



۲- در شکل زیر اگر انرژی ذخیره شده در خازن
$$C_{\gamma} = \gamma \mu F$$
 برابر γ^{\prime} باشد،

$$q_1=q_7 \xrightarrow{U=rac{1}{\gamma}rac{q}{C}} U_1 = rac{C_1}{C_{\gamma}} \Rightarrow U_7 = rac{1}{\gamma}U_1 = rac{1}{\gamma}$$

در خازنهای سری انرژی به نسبت عکس ظرفیت است و در خازنهای موازی انرژی با ظرفیت نسبت مستقیم دارد. $U_{1,\gamma}=U_{1}+U_{2}=1$

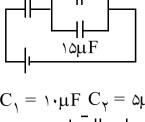
$$V_{1,\gamma} = V_{\gamma} \xrightarrow{U = \frac{1}{\gamma} C V^{\gamma}} \frac{U_{1,\gamma}}{U_{\gamma}} = \frac{C_{1,\gamma}}{C_{\gamma}} \Rightarrow U_{\gamma} = 1 \cdot U_{\gamma} = 1 \cdot J$$

$$C_{1,\gamma} = \frac{C_1 C_{\gamma}}{C_1 + C_{\gamma}} = 1/9 \mu F$$

$$U_{\beta} = U_1 + U_{\gamma} + U_{\gamma} = 1/4 + 1/7 + 1 = 11 J$$

۳- در مدار شکل مقابل بار خازن μF چند برابر بار خازن μF است؟

. گزینه ۴ پاسخ صحیح است
$$\frac{q_{\gamma}}{q_{\gamma}} = \frac{C_{\gamma}}{C_{\gamma}} \Rightarrow q_{\gamma} = \gamma q_{\gamma} \quad \text{of} \quad q_{\gamma} = q_{\gamma} + q_{\gamma} = \gamma q_{\gamma}$$

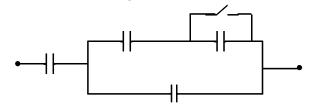


$$C_{\gamma} = \gamma \cdot \mu F C_{\gamma} = \delta \mu F$$

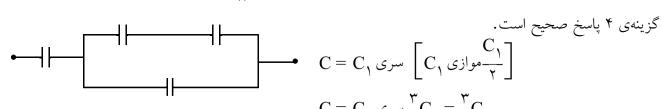
$$- \mu F C_{\gamma} = \delta \mu F$$

$$- \mu F C_{\gamma} = \delta \mu F$$

۴- در شکل مقابل خازنها مشابهند. با بستن کلید ظرفیت معادل مجموعه چند برابر می شود؟



$$\frac{\mu}{2}$$
 (7 $\frac{\mu}{2}$ (7



$$\mathbf{C} = \mathbf{C}_{1}$$
 سری $\left[\mathbf{C}_{1}, \frac{\mathbf{C}_{1}}{\mathbf{Y}}\right]$

$$C = C_{\gamma}$$
 سری $\frac{r}{r}C_{\gamma} = \frac{r}{\delta}C_{\gamma}$

$$C' = C_1$$
 سری $TC_1 = \frac{7}{7}C_1$

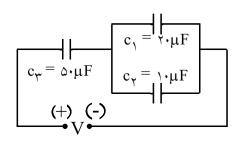
$$\frac{\mathbf{C'}}{\mathbf{C}} = \frac{\mathbf{C'}}{\mathbf{C'}} = \frac{\mathbf{C'}}{\mathbf{C'}} = \frac{\mathbf{C'}}{\mathbf{C}}$$

۵- خازن شارژ شدهای را از باتری جدا کردهایم. اگر فاصلهی بین دو صفحه آن را دو برابر کنیم:

- ۱) اندازهی میدان الکتریکی بین دو صفحه تغییر نمی کند.
 - ۲) بار آن نصف می شود.
 - ۳) انرژی آن نصف می شود.
 - ۴) اختلاف پتانسیل بین دو صفحه نصف می شود.

گزینهی ۱ پاسخ صحیح است.

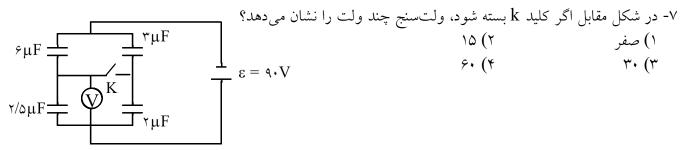
$$C = \frac{K\epsilon, A}{d} \xrightarrow{d' = rd} C' = \frac{1}{r}C$$
 $U = \frac{1}{r} \frac{q}{C} \Rightarrow U' = rU$.بار ثابت است. $V = \frac{q}{C} \Rightarrow V' = rV$
 $E = \frac{V}{d} \xrightarrow{V' = rd} E' = E$



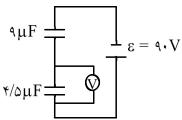
۶- در مدار نشان داده شده در شکل، اختلاف پتانسیل دو سر خازن شمارهی

است؛ بار خازن شماره ی ۳ چند μC است؛ ν

گزینهی ۳ صحیح است.



گزینهی ۴ پاسخ صحیح است. اگر کلید را ببندیم مدار به صورت مقابل درمی آید و در خازنهای متوالی، ولتاژ به نسبت عکس ظرفیت تقسیم می شود. پس از ۹۰ ولت، ۶۰ ولت به دو سر خازن ۴/۵ میکروفارادی و ۳۰ ولت به دو سر خازن ۹۸ میکروفارادی خواهد رسید.



۸- در یک خازن تخت، ظرفیت خازن ۵nF، بار ذخیره شده در خازن ۲۰nC و فاصلهی بین دو صفحه خازن ۱mm، است. اندازهی بردار شدت میدان الکتریکی در فضای بین دو صفحه ی خازن چند Volt/m است؟

گزینهی ۱ پاسخ صحیح است.

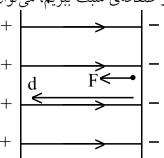
$$C = \frac{q}{V} \Rightarrow \delta = \frac{? \cdot}{V} \Rightarrow V = ?Volt$$

$$V = Ed \Rightarrow ? = E \times \cdot / \cdot \cdot \cdot \Rightarrow E = ? \cdot \cdot \cdot Volt/m$$

توضیح در مورد رابطهی V=Ed: اگر در میدان یکنواخت بین دو صفحهی خازن، ذرهای بار مثبت با بار \mathbf{q} , را با سرعت ثابت از صفحهی مثبت ببریم، می توان گفت:

$$W = Eq$$
 , d : $W = Eq$, d $W = \Delta U \Rightarrow \Delta U = Eq$, d $\Delta V = \frac{\Delta U}{q} = \frac{Eq}{q} = Ed$

V=Ed در خازن ΔV را با V نشان داده ایم.پس



۹- خازن $C_{\gamma}=4\cdot \mu F$ را با اختلاف پتانسیل $V_{\gamma}=4\cdot (V)$ و خازن $C_{\gamma}=6\cdot \mu F$ را با اختلاف پتانسیل $V_{\gamma}=6\cdot \mu F$ را با اختلاف پتانسیل $V_{\gamma}=6\cdot \mu F$ شارژ کرده، سپس صفحات همنام آنها را به هم متصل می کنیم. بار ذخیره شده روی صفحات خازن $V_{\gamma}=10\cdot (V)$ پس از برقراری تعادل چند برابر خواهد شد؟

$$\Upsilon$$
 (Υ) (Υ

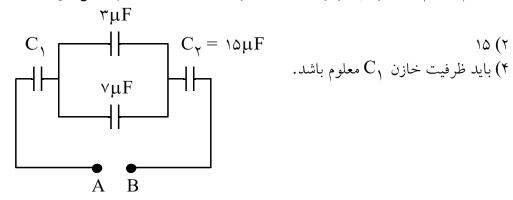
گزینهی ۲ پاسخ صحیح است.

$$\begin{aligned} q_{1} &= C_{1} V_{1} = \text{div} \times \text{fin} = \text{fin} \mu C \\ q_{2} &= C_{2} V_{2} = \text{fin} \times \text{th} = \text{div} \times \text{fin} = \text{div} \times \text{fin} \\ q_{3} &= C_{4} V_{4} = \text{fin} \times \text{th} = \text{div} \times \text{fin} =$$

$$V' = \frac{\begin{vmatrix} C_1 V_1 \pm C_7 V_7 \end{vmatrix}}{C_1 + C_7}$$
اتصال صفحات همنام

نکتهی درسی:

A اگر انرژی ذخیره شده در خازنهای C_{γ} و C_{γ} به ترتیب برابر ۷۵ و ۳۰ میکروژول باشد، اختلاف پتانسیل بین نقاط C_{γ}



$$C_{\gamma}$$
 باید ظرفیت خازن C_{γ} معلوم باشد.

$$U_{\gamma} = r \boldsymbol{\cdot} \mu \, J \Rightarrow \frac{1}{r} \, \frac{q_{\gamma}^{\, r}}{C} = r \boldsymbol{\cdot} \Rightarrow \frac{1}{r} \, \frac{q_{\gamma}^{\, r}}{10} = r \boldsymbol{\cdot} \Rightarrow q_{\gamma} = r \boldsymbol{\cdot} \mu C$$

$$q_1 = q_7 = \text{rim}C$$

خازنهای C_{γ} , C_{γ} متوالی هستند لذا بار برابر دارند.

$$U_{1} = v \Delta \mu J \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{q_{1}^{r}}{C_{1}} = v \Delta \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{(r \cdot)^{r}}{C_{1}} = v \Delta \Rightarrow C_{1} = \rho \mu F$$

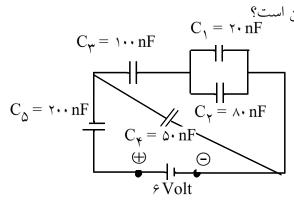
خازن معادل کل مدار را به دست می آوریم در شرایطی که دو خازن ${^{
abla}\mu F}$, ${^{lpha}\mu F}$, ${^{lpha}\mu F}$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C'} + \frac{1}{C_r} = \frac{1}{9} + \frac{1}{r+v} + \frac{1}{10} = \frac{\delta + r + r}{r} \Rightarrow C_T = r\mu F$$

$$q_T = q_1 = q_7 = q_7 = \gamma \cdot \mu C$$

$$q_T = C_T V_T \Rightarrow V_T = \frac{q_T}{C_T} = \frac{r_{\bullet}}{r} = V_{\bullet} \Rightarrow V_{AB} = V_{\bullet}$$
 ولت

 $C_1 = \text{r. nF}$ (1) $C_1 = \text{r. nF}$ (7) $C_2 = \text{r. nF}$ (8) $C_3 = \text{r. nF}$ (9) $C_4 = \text{r. nF}$ (1) $C_5 = \text{r. nF}$ (1) $C_5 = \text{r. nF}$



$$C_{1\gamma} = C_{1} + C_{\gamma} = \gamma \cdot + \lambda \cdot = \gamma \cdot \cdot (nF)$$

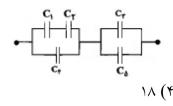
$$\frac{1}{C_{1\gamma\gamma}} = \frac{1}{C_{1\gamma}} + \frac{1}{C_{\gamma}} = \frac{1}{\gamma \cdot \cdot} + \frac{1}{\gamma \cdot \cdot} = \frac{1}{\delta \cdot} \Rightarrow C_{1\gamma\gamma} = \delta \cdot (nF)$$

$$C_{1\gamma\gamma\gamma} = C_{1\gamma\gamma} + C_{\gamma} = \delta \cdot + \delta \cdot = \gamma \cdot \cdot (nF)$$

$$\frac{1}{C_{T}} = \frac{1}{C_{1\gamma\gamma\gamma}} + \frac{1}{C_{\delta}} = \frac{1}{\gamma \cdot \cdot} + \frac{1}{\gamma \cdot \cdot} = \frac{\gamma}{\gamma \cdot \cdot} \Rightarrow C_{T} = \frac{\gamma \cdot \cdot}{\gamma} (nF)$$

$$q_{T} = C_{T}V_{T} = \frac{\gamma \cdot \cdot}{\gamma} \times \beta = \gamma \cdot \cdot (nC)$$

$$\begin{aligned} q_{1\gamma\gamma\gamma} &= q_T = \ast \cdot \cdot (nC) \ , \ V_{1\gamma\gamma\gamma} &= \frac{q_{1\gamma\gamma\gamma}}{C_{1\gamma\gamma\gamma}} = \frac{\ast \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot} = \ast (Volt) \\ V_{1\gamma\gamma} &= V_{1\gamma\gamma\gamma} = \ast (volt) \ , \ q_{1\gamma\gamma} &= C_{1\gamma\gamma} V_{1\gamma\gamma} = \delta \cdot \times \ast = \gamma \cdot \cdot (nC) \\ q_{1\gamma} &= q_{1\gamma\gamma} = \gamma \cdot \cdot (nC) \ , \ V_{1\gamma} &= \frac{q_{1\gamma}}{C_{1\gamma}} = \frac{\gamma \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot} = \gamma (Volt) \\ V_{1} &= V_{1\gamma} = \gamma (volt) \ , \ q_{1} &= C_{1} V_{1} = \gamma \cdot \times \gamma = \ast \cdot (nC) \end{aligned}$$



۲- در شکل مقابل خازنها مشابهند و حداکثر ولتاژ قابل تحمل برای هر کدام ۱۲ ولت است. حداکثر اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه چند ولت باشد تا هیچکدام از خازنها آسیب نبینند؟ ۱) ۲۴ گزینهی ۲ پاسخ صحیح است. ٣۶ (٣

باید V_t آنقدر باشد که حتی خازنی که بیشترین ولتاژ را دارد از ۱۲ ولت بالاتر نرود. پس ابتدا خازنی را پیدا میکنیم که بیشترین ولتاژ را دارد. چون خازنها مشابهند آنکه بیشترین بار را دارد بیشترین ولتاژ را خواهد داشت.

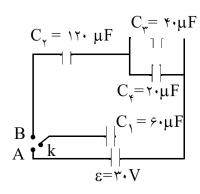
$$rac{q_{1,7}}{q_{4}} = rac{C_{1,7}}{C_{4}} = rac{1}{7}$$
 باید بین q_{4} و $q_{1,7}$ به نسبت ۲ به ۱ تقسیم شود و q_{t}

$$\mathbf{q}_{1}=\mathbf{q}_{7}=\frac{1}{7}\mathbf{q}_{t}$$
 , $\mathbf{q}_{7}=\frac{7}{7}\mathbf{q}_{t}$

$$rac{q_{
m w}}{q_{
m o}} = rac{C_{
m w}}{C_{
m o}} = rac{1}{1}$$
 یعنی $q_{
m t}$ بین $q_{
m c}$ به طور مساوی تقسیم می شود $q_{
m t}$

$$q_{\gamma} = q_{\delta} = \frac{1}{\gamma} q_t$$

$$rac{V_{174}}{V_{70}}=rac{C_{70}}{C_{174}}$$
 ست $V_{70}=0$ بس بیشترین ولتاژ مربوط به $V_{70}=0$ است $V_{70}=0$



 $C_{\eta}= \mathfrak{r}\cdot \mu F$ وصل A وصل کنیم و سپس از وضع A جدا کرده و به وضع A وصل کنیم، بار خازن A چند A جدا کرده و به وضع A میکروکولن می شود؟

- 1.4. (1
- 9 . . (7
- ٧٢٠ (٣
- 11.. (4

گزینه ی ۱ پاسخ صحیح است. اگر دو خازن C_{γ} و را با ولتاژهای V_{γ} شاژر کنیم، از ولتاژها جدا کرده و به هم وصل کنیم در این صورت بار الکتریکی از یک خازن به دیگری میرود تا هر دو اختلاف پتانسیل یکسان V پیدا کنند. با استفاده از پایستگی بار الکتریکی می توانیم بنویسیم:

$$V = \frac{\left|C_{1} V_{1} \pm C_{2} V_{2}\right|}{\left|C_{1} + C_{2}\right|}$$

علامت مثبت مربوط به اتصال صفحات همنام خازنها و علامت منفی مربوط به اتصال صفحات ناهمنام خازنها می باشد. همچنین بار الکتریکی جدید خازنها باید با ولتاژ جدید V حساب شود. (q=CV) می باشد. همچنین بار الکتریکی جدید خازنها را پر کنیم و به خازن خالی دیگری وصل کنیم به عنوان نمونه (q=CV) با (q=CV) در حالت خاصی که یکی از خازنها را پر کنیم و به خازن خالی دیگری وصل کنیم به عنوان نمونه (q=CV) و (

حل: در مدار شکل فوق خازن C_{γ} با ولتاژ γ با ولتاژ γ پر شده و به مجموعهای از خازنها که آنها را به یک خازن تبدیل می کنیم وصل می شود.

$$\begin{aligned}
\mathbf{r} \cdot + \mathbf{r} \cdot &= \mathbf{r} \cdot \Rightarrow \mathbf{C}' = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{r} \cdot \mu \mathbf{F}, \quad \mathbf{V} = \frac{\mathbf{C}_{1} \mathbf{V}_{1}}{\mathbf{C}_{1} + \mathbf{C}'} \\
\Rightarrow \mathbf{V} = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{V}), \quad \mathbf{q}'_{1} = \mathbf{C}_{1} \mathbf{V} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \\
\Rightarrow \mathbf{V} = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{V}), \quad \mathbf{q}'_{1} = \mathbf{C}_{1} \mathbf{V} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} \cdot$$

۱۴- خازنهای شکل مقابل ظرفیتهای یکسان دارند و انرژی کل مجموعهی مدار $\mathbf u$ است. اگر کلید را ببندیم، انرژی کل

مدار 'u می شود. نسبت
$$\frac{u'}{u}$$
 چند است؟ (به دو سر A و B اختلاف پتانسیل ثابت V بسته شده است).
$$C_1 \qquad C_1 \qquad$$

گزینهی ۱ پاسخ صحیح است. چون ولتاژ دو سر مدار ثابت است پس کافی است ظرفیت معادل مدار را در دو حالت بررسی کنیم. وقتی کلید را ببندیم سه خازن موازی وسط مدار حذف (اتصال کوتاه) میشوند.

$$u = \frac{1}{7}CV^{7}$$

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_1} \rightarrow C_t = \frac{C_1}{V}$$
 : کلید باز:

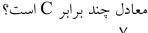
كليد

$$\frac{1}{C'_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_1} \rightarrow C'_t = \frac{C_1}{r}$$

$$C_1$$

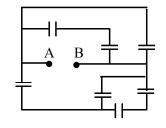
$$\frac{\mathbf{u'}}{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{C'}_{t}}{\mathbf{C}_{t}} = \frac{\frac{\mathbf{C}_{1}}{\mathbf{r}}}{\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{C}_{1}}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{s}}$$

۱۵-هفت خازن مشابه با ظرفیت C در مداری مطابق شکل مقابل قرار دارند. ظرفیت خازن

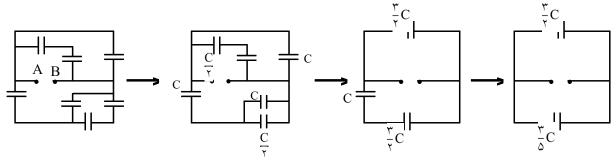


$$\frac{r}{V}$$
 (7

$$\frac{r_1}{r_2}$$
 (*



گزینهی ۴ پاسخ صحیح است. مراحل معادلسازی به صورت زیر است:



$$\rightarrow C_T = \frac{7}{7}C + \frac{5}{4}C = \frac{7}{7}C$$

۱۶- در شکل مقابل فضای بین صفحات خازنها خالی است. اگر یک دیالکتریک وارد فضای بین دو صفحه ی ${
m C}_{
m v}$ نماییم بار خازنهای C_{v} و C_{v} چگونه تغییر می کند؟



و بات
$$q_{\gamma}$$
 افزایش، q_{γ} کاهش و q_{γ} ثابت q_{γ}

۳)
$$q_{\nu}$$
 افزایش، q_{ν} و q_{ν} کاهش

$$q_{\nu}$$
 کاهش، q_{ν} و q_{ν} افزایش q_{ν}

گزینه کی ۱ پاسخ صحیح است. با وارد کردن عایق ظرفیت $C_{\rm t}$ زیاد می شود $C_{\rm t}$ و در نتیجه $C_{\rm t}$ هم زیاد

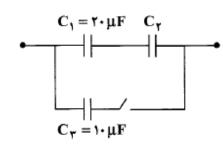
$$(C_{\gamma,\pi} = C_{\gamma} + C \Rightarrow \text{ on mee} C_{\gamma,\pi} \qquad \frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_{\gamma}} + \frac{1}{C_{\gamma,\pi}} \xrightarrow{\pi_{\gamma}} \frac{1}{C_t} \Rightarrow C_t \text{ on mee} C_t \Rightarrow C_t$$

$$\mathbf{q_t} = \mathbf{C_t} \mathbf{V_t} \xrightarrow{\mathbf{q_t}} \mathbf{q_t} \mathbf{v_t} \xrightarrow{\mathbf{q_t}} \mathbf{q_t} \mathbf{q_t} \xrightarrow{\mathbf{q_t}} \mathbf{q_t} \mathbf{q_t}$$

$$\mathbf{q_t} = \mathbf{C_t} \mathbf{V_t} \xrightarrow{\mathbf{q_t}} \mathbf{q_t} \mathbf{q_t} \mathbf{q_t}$$

$$V_{\text{N}}+V$$
 کاهش q_{N} کاهش q_{N} کاهش q_{N} کاهش q_{N} کاهش q_{N} کاهش و کاهش q_{N} کاهش q_{N} کاهش و کاهش q_{N} کاهش و کامش و

$$q_{\gamma} + q_{\gamma} = q_{\gamma} \xrightarrow{q_{\gamma}} q_{\gamma}$$
افزایش $q_{\gamma} \rightarrow q_{\gamma}$ کاهش

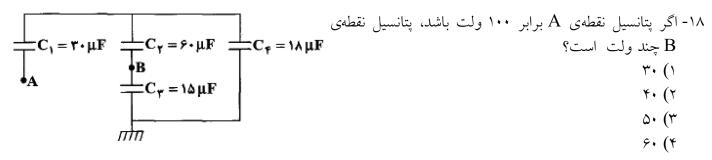


۱۷- در شکل مقابل دو سر مجموعه از مدار جدا شده است و خازن \mathbb{C}_{w} بدون بار است. اگر با بستن کلید، اختلاف پتانسیل ۲ سر ۲٫ نصف شود، ظرفیت ۲٫ چند میکروفاراد است؟ چند میکروفاراد است؟

$$V_{1}=rac{q_{1}}{C_{1}}$$
 نصف می شود. $q_{1}=q_{2}=q_{3}$ نصف می شود. $q_{1}=q_{2}=q_{3}$ نصف می شود. $q_{1,2}=q_{3}=q_{3}$

 C_{γ} و البت است یعنی $q_{1,\gamma}$ حالت اول برابر است با $q_{1,\gamma}$ است با $q_{1,\gamma}$ حالت دوم، پس نیمی از بار $q_{1,\gamma}$ به q_{t} منتقل می شود یعنی در حالت دوم $q_{\gamma}=q_{\gamma}$.

$$\Rightarrow V_{1,7} = V_{\gamma} \xrightarrow{q_{1} g_{\gamma} = q_{\gamma}} C_{1,7} = C_{\gamma} \Rightarrow (7 \cdot C_{\gamma}) = 1 \cdot \Rightarrow \frac{7 \cdot C_{\gamma}}{7 \cdot + C_{\gamma}} = 1 \cdot \Rightarrow C_{\gamma} = 7 \cdot \mu F$$



 V_B گزینه کی ۲ پاسخ صحیح است. V_A برابر V_B و V_t برابر V_A است.

$$\begin{split} &C_{\gamma},_{\gamma},_{\gamma} = C_{\gamma} + \frac{C_{\gamma} \cdot C_{\gamma}}{C_{\gamma} + C_{\gamma}} = \text{in} + \frac{\text{s. n. no}}{\text{vo}} = \text{v. mf} \\ &C_{\gamma} = C_{\gamma},_{\gamma},_{\gamma} = q_{\gamma} = q_{\gamma},_{\gamma},_{\gamma} \Rightarrow V_{\gamma} = V_{\gamma},_{\gamma},_{\gamma} = \frac{\text{in}}{\gamma} V_{t} = \text{o. (v)} \\ &\begin{cases} V_{\gamma} + V_{\gamma} = \text{o.} \\ C_{\gamma} & V_{\gamma} = C_{\gamma} & V_{\gamma} \Rightarrow V_{\gamma} = \text{f. (v)} \end{cases} \Rightarrow V_{\gamma} = \frac{\text{f. no}}{\delta} \times \text{o.} = \text{f. (v)} \end{split}$$

۲۵ مجموعه خازنی به ظرفیت معادل ۲۵ مجموعه خازنی به ظرفیت معادل ۲۵ مجموعه خازنی به ظرفیت معادل ۲۵ میکروفاراد ساخته یم. اگر اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه ۱۲ ولت باشد، بار C_{γ} چند میکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم. اگر اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه ۲۸ ولت باشد، بار C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم. اگر اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه ۲۸ ولت باشد، بار C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم. اگر اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه ۲۸ ولت باشد، بار C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم از نازن C_{γ} همیکروفاراد ساخته یم از نازن C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم از نازن C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروفاراد ساخته یم از نازن C_{γ} همیکروکولن است؟ میکروکولن است? میکروکولن است?

گزینهی ۳ پاسخ صحیح است.

* ظرفیت معادل ترکیب موازی از ظرفیت هر یک از خازنها بزرگتر است.

$$C_t = C + C' > C, C'$$

* ظرفیت معادل ترکیب سری از ظرفیت هر یک از خازنها کوچکتر است.

$$C_t < C, C'$$
 $C_{t,y}$
 $C_t = \gamma \delta, C_y = \gamma \delta, C_y = \gamma \delta$

از $C_{\gamma,\psi}$ بیش تر است پس حتماً $C_{\gamma,\psi}$ با $C_{\gamma,\psi}$ موازی است.

$$\bullet \land \circ = \land \circ + C_{\uparrow, \gamma} \Rightarrow C_{\uparrow, \gamma} = \circ$$

است. $C_{\gamma,\gamma}$ قطعاً ترکیب سری $C_{\gamma,\gamma}$

$$V_{\text{Y,Y}} = V_{\text{t}} \Rightarrow q_{\text{Y,Y}} = C_{\text{Y,Y}} \ V_{\text{t}} = \delta \times \text{ if } = \text{s. } \mu C \Rightarrow q_{\text{Y}} = q_{\text{Y}} = \text{s. } \mu C$$

و $C_{
m v}=7$ را به هم میبندیم و دو سر مجموعه را به اختلاف $C_{
m v}=7$ و $C_{
m v}=7$ را به هم میبندیم و دو سر مجموعه را به اختلاف $C_{
m v}=8$ پتانسیل ۲۰۰ ولت وصل میکنیم، بهطوری که بار ذخیره شده در مجموعه برابر ۱۰۰۰ میکروکولن میشود. انرژی یتانسیل الکتریکی ذخیره شده در خازن \mathbb{C}_* چند ژول است؟

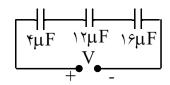
گزینهی ۱ پاسخ صحیح است. با استفاده از بار ذخیره شده در کل مجموعه، ظرفیت معادل C_t را حساب می کنیم، چنانچه C_{f} از ظرفیت تکتک خازنهای موجود در مدار کمتر باشد، اتصال خازنهای فوق، سری بوده و چنانچه بیش تر از ظرفیت تک تک خازنهای موجود در مدار باشد، اتصال خازنهای فوق، موازی بوده است.

$$q = CV \Rightarrow \text{i...} = C \times \text{i...} \Rightarrow C = \text{dmF} \Rightarrow \frac{\text{i}}{C} = \frac{\text{i}}{C_{\text{i}}} + \frac{\text{i}}{C_{\text{f}}} + \dots$$

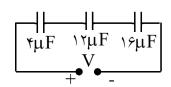
$$\Rightarrow \frac{1}{\Delta} = \frac{1}{9 \cdot 1} + \frac{1}{7 \cdot 1} + \frac{1}{7 \cdot 1} + \frac{1}{C_{\kappa}} \Rightarrow C_{\kappa} = 1 \cdot \mu F$$

$$U_{_{\boldsymbol{\gamma}}} = \frac{q^{^{\boldsymbol{\gamma}}}}{^{\boldsymbol{\gamma}}C_{_{\boldsymbol{\gamma}}}} \Rightarrow U_{_{\boldsymbol{\gamma}}} = \frac{\left(\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\cdot} \cdot \boldsymbol{\cdot}\right)^{^{\boldsymbol{\gamma}}}}{^{\boldsymbol{\gamma}} \times \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\cdot}} \Rightarrow U_{_{\boldsymbol{\gamma}}} = \boldsymbol{\delta} \cdot \boldsymbol{\cdot} \cdot \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\mu} J = \boldsymbol{\cdot} / \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\delta} J$$

در خازنهای سری، بار کل مجموعه و تکتک خازنها برابر است.



 $4 + \frac{1}{4} +$



 $^{\mu F}$ ۱۲ $^{\mu F}$ ۱۶ $^{\mu F}$ ون خازنها متوالی هستند بنابراین بار الکتریکی کل با بار الکتریکی ذخیره شده در تک تک خازنها برابر است بنابراین برای انرژی ذخیره شدهی کل و انرژی ذخیره شده در $^{-}$

خازن ۱۲µF مي توانيم بنويسيم:

$$\frac{W}{W_{17}} = \frac{\frac{1}{7} \frac{q^{7}}{C}}{\frac{1}{7} \frac{q^{7}}{C_{17}}} \Rightarrow \frac{W}{W_{17}} = \frac{C_{17}}{C}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{7} + \frac{1}{17} + \frac{1}{19} \Rightarrow C = \frac{7\Lambda}{19} \mu F$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{7} \frac{q}{C_{17}}}{W_{17}} = \frac{17}{\frac{7\Lambda}{19}} \Rightarrow W_{17} = \frac{17}{19} \Rightarrow W_{17} = \frac{17}{19}$$

- ۲۲- صفحات خازنی که دیالکتریک آن هوا است به مولدی متصل است. در همین حال یک قطعه کائوچو بین صفحات آن قرار میدهیم. کدامیک از گزارههای زیر درست است؟
 - ١) شدت ميدان الكتريكي بين صفحات افزايش مي يابد.
 - ٢) شدت ميدان الكتريكي بين صفحات تغيير نمي كند.
 - ٣) شدت ميدان الكتريكي بين صفحات كاهش مي يابد.
 - ۴) تغییر شدت میدان الکتریکی به نوع کائوچو بستگی دارد.

گزینه ک ۲ پاسخ صحیح است. هنگامی که خازن به مولد (باتری) متصل باقی می ماند، اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر خازن همواره ثابت است، از طرفی می دانیم که شدت میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحه های خازن از رابطه ی $E=\frac{V}{d}$ قابل محاسبه است. در این خازن ولتاژ (V) ثابت و فاصله ی بین دو صفحه ی خازن (b) نیز ثابت است و وارد کردن قطعه ی دی الکتریک بین این دو صفحه، تأثیر بر این مقدارها ندارد. پس شدت میدان الکتریکی بین صفحات خازن تغییر نمی کند. در این جا لازم است که به نقش حضور دی الکتریک در بین صفحه های خازن اشاره ای شود. می دانیم طبق رابطه ی $C=\frac{ke.A}{d}$ هرگاه دی الکتریک بین صفحه های خازن قرار دهیم، ظرفین خازن افزایش می بابد پس با توجه به رابطه ی q=C با افزایش q=C و ثابت بودن q=C ، بار خازن (p) افزایش می بابد. این امر سبب تقویت و افزایش میدان الکتریکی حاصل از بار q=C در فضای بین صفحه های خازن می شود، از سویی دیگر قطبیدگی دی الکتریک بین صفحه های خازن میدان d=C ایجاد می کند، شدت میدان الکتریک بین صفحه های خازن (عیدان (وزیش یافته به گونه ای که مقدار d=C است، بنابراین d=C است، یعنی با افزایش یافته به گونه ای که مقدار d=C همواره ثابت باقی می ماند، یعنی شدت میدان الکتریکی بین صفحه های خازن تغییر نمی کند.

۲۳- خازن مسطحی به ظرفیت μF را به کمک اختلاف پتانسیل νV پر کرده و سپس آن را از منبع پتانسیل قطع می کنیم. حال یکی از صفحه ها را به موازات صفحه ی دیگر جابه جا می کنیم تا نصف مساحت صفحه ها مقابل یک دیگر قرار گیرد. انرژی خازن چه تغییری می کند؟

۱) ۲۰ میلی ژول بیش تر می شود. ۲ میلی ژول کم تر می شود.

۳) ۴۰ میلی ژول بیش تر می شود. ۴ پخیبری نمی کند.

گزینه ی ۱ پاسخ صحیح است. چون پس از شارژ شدن خازن آن را از مولد جدا نمودهایم، بار الکتریکی خازن ثابت و q=C بدون تغییر باقی می ماند.

وقتی صفحههای خازن را جابه جا می کنیم تا نصف مساحت صفحهها مقابل یکدیگر قرار گیرد، بار الکتریکی خازن تغییر آرایش داده و در قسمتی از صفحهها که مقابل هم قرار گرفتهاند، جمع می شود. بنابراین طبق رابطه ی ظرفیت تغییر آرایش داده و در قسمتی از صفحهها که مقابل هم قرار گرفتهاند، جمع می شود. بنابراین طرفیت خازن نیز به الکتریکی خازن تخت $C = \epsilon . \frac{A}{d}$ مساحت مؤثر صفحههای خازن نصف شده است، بنابراین ظرفیت خازن نیز به نصف کاهش می یابد.

$$A_{\gamma} = \frac{1}{\gamma} A_{\gamma} \rightarrow \frac{C_{\gamma}}{C_{\gamma}} = \frac{\epsilon \cdot \frac{A_{\gamma}}{d}}{\epsilon \cdot \frac{A_{\gamma}}{d}} = \frac{A_{\gamma}}{A_{\gamma}} = \frac{1}{\gamma} \rightarrow C_{\gamma} = \frac{1}{\gamma} C_{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \times 1 = \frac{1}{\gamma} \wedge \Delta \mu F$$

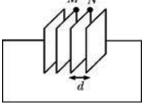
با معلوم بودن بار الکتریکی خازن و ظرفیت الکتریکی خازن در حالتهای اولیه و ثانویه، می توان انرژی الکتریکی ذخیره شده در خازن را با استفاده از رابطهی $U=rac{1}{\gamma}rac{q}{C}$ به دست آورد.

$$\begin{aligned} q_{\gamma} &= q_{\gamma} = q \quad {}_{9}C_{\gamma} = \gamma \mu F \quad {}_{9}C_{\gamma} = \cdot / \delta \ \mu F \\ U_{\gamma} &= \frac{\gamma}{\gamma} \frac{q^{\gamma}}{C_{\gamma}} = \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma \cdot \cdot^{\gamma}}{\gamma} = \gamma \times \gamma \cdot^{\gamma} \mu J = \gamma \cdot mJ \\ U_{\gamma} &= \frac{\gamma}{\gamma} \frac{q^{\gamma}}{C_{\gamma}} = \frac{\gamma}{\gamma} \times \frac{\gamma \cdot \cdot^{\gamma}}{\cdot / \delta} = \gamma \times \gamma \cdot^{\gamma} \mu J = \gamma \cdot mJ \end{aligned}$$

. با محاسبه ی تفاضل انرژی الکتریکی اولیه و ثانویه ی خازن، تغییر انرژی الکتریکی آن را محاسبه می کنیم $\Delta U = U_{\gamma} - U_{\gamma} = 4.$

علّت افزایش انرژی الکتریکی خازن را میتوان در کار مثبت نیروی عامل خارجی برای جابهجا کردن صفحههای خازن دانست. چون بارهای الکتریکی صفحههای خازن ناهمنام هستند یکدیگر را جذب می کنند، عامل خارجی باید نیرویی برخلاف این نیرو به صفحهها اعمال کند تا بتواند آنها را جابهجا کند، قطعاً در این جابهجایی نیروی عامل خارجی کار مثبت انجام می دهد که سبب ایجاد ΔU مثبت شده است.

۲۲- مطابق شکل، چهار صفحه ی رسانا به فاصله ی d از یکدیگر قرار دارند. مساحت هر کدام از صفحات A و بین آنها هوا است. صفحات انتهایی را به یکدیگر متصل می کنیم. ظرفیت معادل بین نقاط M و M می است. صفحات انتهایی را به یکدیگر متصل می کنیم.

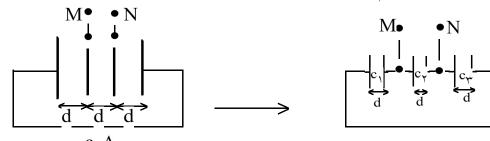


$$\frac{1}{r}\varepsilon.\frac{A}{d}$$
 (7 $\frac{r}{r}\varepsilon.\frac{A}{d}$ (1

N كدام است؟

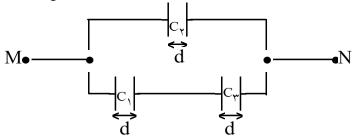
$$\frac{r}{r}\epsilon \cdot \frac{A}{d} (r)$$

گزینه ی ۴ پاسخ صحیح است. باتوجّه به شکل زیر، خازنهایی که در صفحه ی M و در صفحه ی N با هم مشترک هستند را می توانیم تفکیک کنیم و این صفحه ها را به صورت دو صفحه ی جدا بین دو خازن که با سیمی با مقاومت ناچیز به هم متصل هستند، در نظر بگیریم.



به این ترتیب سه خازن مشابه C_{γ} , C_{γ} , C_{γ} , C_{γ} , C_{γ} است.

با توجّه به شکل خازن C_{γ} با خازن C_{ψ} به صورت متوالی قرار گرفته است و مجموعه این دو خازن، با خازن C_{γ} به صورت موازی عمل می کند. ظرفیت معادل بین نقاط M و M، ظرفیت معادل شکل زیر است:



:ار ست بازن معادل، خازنهای \mathbf{C}_{γ} و س \mathbf{C}_{γ} برابر است با

سری
$$: \frac{1}{C'} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_m} \rightarrow \frac{1}{C'} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{1}{C} \rightarrow C' = \frac{C}{T}$$

ظرفیت خازن معادل، خازنهای C_{γ} و C_{γ} برابر است با:

خازنهای موازی :
$$C'' = C' + C_{\gamma} \rightarrow C'' = \frac{C}{\gamma} + C \rightarrow C'' = \frac{\gamma}{\gamma}$$

با جایگزینی مقدار C از رابطهی بالا، ظرفیت معادل بین دو نقطهی M و M بر حسب فاصلهی بین صفحهها (a) و مساحت سطح آنها (a) به دست می آید.

$$C_{MN} = C'' = \frac{r}{r} \times \frac{\epsilon \cdot A}{d} \rightarrow C_{MN} = \frac{r\epsilon \cdot A}{rd}$$